

新聞稿

XFAB 在 0.18um 高壓製程提供嵌入式快閃記憶體(eFlash)

XH018 嵌入式快閃記憶體(eFlash) 對高階系統晶片(SoCs)提供業界高成本效益的高壓製程整合方案

2011 年 7 月 5 日，德國艾爾福特(Erfurt) – X-FAB Silicon Foundries 在 XH018 0.18um 高壓製程上增加高可靠性的嵌入式快閃記憶體(eFlash)方案。此項方案提供業界最低的光罩層數，32 層，其中包含數位、類比、高壓元件、並快閃記憶體，而快閃記憶體只需要額外 2 層光罩。對高階系統晶片(SoCs)，此方案具有極高的成本效益，而且其中的 45V 高壓元件與嵌入式的記憶體，EEPROM、非揮發性隨機記憶體(NVRAM)、與嵌入式快閃記憶體(eFlash)，更適用於高速微處理器，數位電源，與車用電子。X-FAB 將在亞洲時間 2011 年 7 月 13 日舉辦一場免費的網路研討會來討論此項 “簡單且可靠的非揮發性記憶體(NVM) – 0.18um 的嵌入式快閃記憶體(eFlash)與嵌入式非揮發性記憶體(eNVM)”。

兩個不同的記憶體方塊 – 8K x 32-bit 和 16K x 32bit – 新穎的 XH018 嵌入式快閃記憶體(eFlash) 方案易於整合、快速存取，比非嵌入式記憶體更耐用。此方案包含程式碼錯誤修正(ECC)的功能，允許程式在執行的同時修正錯誤。在 1.8V 或 3.3V 操作電壓下，提供快速讀取(50nS)，並且不受溫度、操作電壓、與製程漂移的影響，而且支援低功耗(200uA/MHz)、與高溫讀取(攝氏 175 度)的特性。

XFAB 總裁 Rudi De Winter 表示「客戶告訴我們，他們需要嵌入式快閃記憶體(eFlash)作為平台來研發整個系列的產品。因著我們 XH018 嵌入式快閃記憶體(eFlash)方案，客戶可以輕易地藉由

修改軟體來改變各樣產品的性能與架構。因此，客戶只要有一個高可靠性與高整合性的電路架構，就可以開發全系列的產品。對於講求成本效益與複雜性的系統晶片(SoCs)，XH018 嵌入式快閃記憶體(eFlash)方案提供一項完美且包含高壓製程的組合。」

XH018 嵌入式快閃記憶體(eFlash)方案也結合 X-FAB 現行的嵌入式非揮發性記憶體(NVM)，包含一次性可程式化(OTP)與非揮發性隨機記憶體(NVRAM)。XFAB 更提供編譯工具幫助工程師依據自身的需求來規劃記憶體的使用。

XH018 嵌入式非揮發性記憶體(NVM)的設計套件與矽智財(IP)已開放授權並可於 X-FAB 技術中心(X-TIC)下載使用，其中 EEPROM 將於 2011 年的第四季開放授權。而完備的矽智財與電路方塊正在進行廣泛地測試與驗證，X-FAB 計畫於 2012 年初提供不同的記憶體大小與高溫的特性數據。

X-FAB 簡介

X-FAB 是頂尖的類比/數位積體電路(混合訊號 IC)的晶圓代工業者。X-FAB 目前全球員工人數約為 2400 名，代工廠位於德國的艾爾福特(Erfurt)與德勒斯登(Dresden)、美國德州的樂波市(Lubbock)和馬來西亞沙勞越的古晉(Kuching)。代工製程以先進模組化 CMOS 與 BiCMOS 為基礎，搭配 1.0 到 0.18 微米技術，涵蓋以汽車、通信、消費性產品與工業部門為主的各種應用。相關資訊，請上網查詢：www.xfab.com

X-FAB 聯絡人

Thomas Hartung
VP Marketing
+49-361-427-6160
thomas.hartung@xfab.com

X-FAB Semiconductor Foundries AG
Haarbergstr. 67
99097 Erfurt, Germany

ThinkBold Corporate Communications
Dagmar Berendes
+1-408-379-2344
dagmar@thinkbold.com

Sarah Miller
+1-231-264-8636
sarah@thinkbold.com